



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109065753 A

(43)申请公布日 2018.12.21

(21)申请号 201810873612.X

(22)申请日 2018.08.02

(71)申请人 京东方科技集团股份有限公司

地址 100015 北京市朝阳区酒仙桥路10号

(72)发明人 谢蒂旒 李伟

(74)专利代理机构 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274

代理人 申健

(51)Int.Cl.

H01L 51/52(2006.01)

H01L 27/32(2006.01)

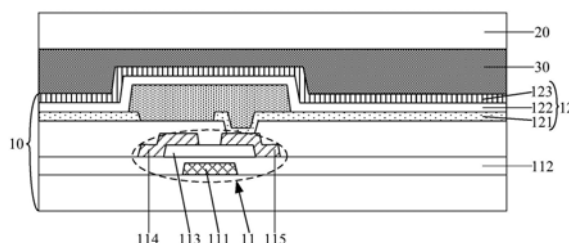
权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

一种顶发光型OLED显示面板及其制备方法

(57)摘要

本发明实施例提供一种顶发光型OLED显示面板及其制备方法,涉及显示技术领域,可在不影响顶发光型OLED显示面板的良率的情况下,提高顶发光型OLED显示面板的显示效果。一种顶发光型OLED显示面板,包括阵列基板和封装盖板,所述阵列基板包括OLED发光器件,所述OLED发光器件包括发光功能层、以及设置于所述发光功能层靠近所述封装盖板一侧的第一电极层,还包括填充于所述阵列基板与所述封装盖板之间、用于粘接所述阵列基板与所述封装盖板的透明导电胶;其中,所述透明导电胶与所述第一电极层直接接触。



1. 一种顶发光型OLED显示面板,包括阵列基板和封装盖板,所述阵列基板包括OLED发光器件,所述OLED发光器件包括发光功能层、以及设置于所述发光功能层靠近所述封装盖板一侧的第一电极层,其特征在于,还包括填充于所述阵列基板与所述封装盖板之间、用于粘接所述阵列基板与所述封装盖板的透明导电胶;

其中,所述透明导电胶与所述第一电极层直接接触。

2. 根据权利要求1所述的顶发光型OLED显示面板,其特征在于,所述封装盖板包括多个子像素区域、以及位于相邻所述子像素区域之间的非子像素区域,所述封装盖板的所述非子像素区域设置有隔垫物和导电层;

其中,所述导电层与所述透明导电胶直接接触。

3. 根据权利要求2所述的顶发光型OLED显示面板,其特征在于,所述导电层设置于所述隔垫物靠近所述阵列基板一侧;或者,所述导电层设置于所述隔垫物远离所述阵列基板一侧。

4. 根据权利要求2或3所述的顶发光型OLED显示面板,其特征在于,所述导电层的材料包括金属。

5. 根据权利要求1所述的顶发光型OLED显示面板,其特征在于,所述透明导电胶包括树脂、以及掺杂在所述树脂中的导电粒子;

或者,所述透明导电胶为具有粘附性的导电聚合物。

6. 根据权利要求5所述的顶发光型OLED显示面板,其特征在于,所述导电粒子包括石墨烯、碳纳米管、足球烯、金属纳米颗粒、以及金属纳米线中的至少一种。

7. 一种顶发光型OLED显示面板的制备方法,所述顶发光型OLED显示面板包括发光功能层、以及设置于所述发光功能层靠近所述封装盖板一侧的第一电极层,其特征在于,所述制备方法包括:

在所述阵列基板与所述封装盖板之间填充透明导电胶,所述透明导电胶用于粘结所述阵列基板与所述封装盖板;

其中,所述透明导电胶与所述第一电极层直接接触。

8. 根据权利要求7所述的顶发光型OLED显示面板的制备方法,其特征在于,所述透明导电胶形成于所述封装盖板上。

9. 根据权利要求7所述的顶发光型OLED显示面板的制备方法,其特征在于,所述封装盖板包括多个子像素区域、以及位于相邻所述子像素区域之间的非子像素区域,所述方法还包括:

在所述封装盖板的所述非子像素区域形成隔垫物和导电层;

其中,所述导电层与所述透明导电胶直接接触。

10. 根据权利要求9所述的顶发光型OLED显示面板的制备方法,其特征在于,所述在所述封装盖板的所述非子像素区域形成隔垫物和导电层,包括:

在所述封装盖板的所述非子像素区域依次形成隔垫物和导电层;

或者,在所述封装盖板的所述非子像素区域依次形成导电层和隔垫物。

一种顶发光型OLED显示面板及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种顶发光型OLED显示面板及其制备方法。

背景技术

[0002] 有机发光二极管 (OLED, Organic Light Emitting Display, 简称OLED发光二极管) 是当今显示领域的热点研究对象之一,与液晶显示器相比, OLED显示器具有功耗低、自发光、生产成本低、视角宽、及响应速度快等优点。目前,对于手机、掌上电脑 (Personal Digital Assistant, 简称PDA)、平板电脑、数码相机等产品, OLED显示器已经逐渐取代传统的液晶显示器。

[0003] OLED显示器的其中一种发光模式是顶发光,顶发光的出光方向为阵列基板指向封装盖板的方向,其要求阴极材料的透明度越高越好,否则,会影响显示面板的显示亮度。因此,为了提高阴极的透光率,就得将阴极的厚度做得非常薄,但是阴极的厚度越薄,其电阻就越大,当阴极的电阻过大时,一方面,会使OLED显示器中像素的充电速率减慢,影响OLED显示器显示画面的刷新速率,从而影响用户的观看体验;另一方面,在电流相同的情况下,阴极的压降 (IR drop) 过大,从而影响显示面板显示性能。

[0004] 基于此,现有技术采用增加辅助阴极的方式来降低阴极的电阻,辅助阴极可以设置在阵列基板或封装盖板上,在辅助阴极位于阵列基板上的情况下,需通过激光打孔的方式使辅助阴极与阴极电连接,而激光打孔工艺会导致背板良率下降,且激光打孔所用的设备的成本较高;在辅助阴极位于封装盖板上的情况下,需将封装盖板上的辅助阴极与阵列基板上的阴极电连接,这样高难度的跨接工艺也会使OLED显示器的良率受到很大影响。

发明内容

[0005] 本发明的实施例提供一种顶发光型OLED显示面板及其制备方法,可在不影响顶发光型OLED显示面板的良率的情况下,提高顶发光型OLED显示面板的显示效果。

[0006] 为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:

[0007] 一方面,提供一种顶发光型OLED显示面板,包括阵列基板和封装盖板,所述阵列基板包括OLED发光器件,所述OLED发光器件包括发光功能层、以及设置于所述发光功能层靠近所述封装盖板一侧的第一电极层,还包括填充于所述阵列基板与所述封装盖板之间、用于粘接所述阵列基板与所述封装盖板的透明导电胶;其中,所述透明导电胶与所述第一电极层直接接触。

[0008] 可选的,所述封装盖板包括多个子像素区域、以及位于相邻所述子像素区域之间的非子像素区域,所述封装盖板的所述非子像素区域设置有隔垫物和导电层;其中,所述导电层与所述透明导电胶直接接触。

[0009] 进一步可选的,所述导电层设置于所述隔垫物靠近所述阵列基板一侧;或者,所述导电层设置于所述隔垫物远离所述阵列基板一侧。

[0010] 可选的,所述导电层的材料包括金属。

[0011] 可选的,所述透明导电胶包括树脂、以及掺杂在所述树脂中的导电粒子;或者,所述透明导电胶为具有粘附性的导电聚合物。

[0012] 进一步可选的,所述导电粒子包括石墨烯、碳纳米管、足球烯、金属纳米颗粒、以及金属纳米线中的至少一种。

[0013] 另一方面,提供一种顶发光型OLED显示面板的制备方法,所述顶发光型OLED显示面板包括发光功能层、以及设置于所述发光功能层靠近所述封装盖板一侧的第一电极层,所述制备方法包括:在所述阵列基板与所述封装盖板之间填充透明导电胶,所述透明导电胶用于粘结所述阵列基板与所述封装盖板;其中,所述透明导电胶与所述第一电极层直接接触。

[0014] 可选的,所述透明导电胶形成于所述封装盖板上。

[0015] 可选的,所述封装盖板包括多个子像素区域、以及位于相邻所述子像素区域之间的非子像素区域,所述方法还包括:在所述封装盖板的所述非子像素区域形成隔垫物和导电层;其中,所述导电层与所述透明导电胶直接接触。

[0016] 进一步可选的,所述在所述封装盖板的所述非子像素区域形成隔垫物和导电层,包括:在所述封装盖板的所述非子像素区域依次形成隔垫物和导电层;或者,在所述封装盖板的所述非子像素区域依次形成导电层和隔垫物。

[0017] 本发明实施例提供一种顶发光型OLED显示面板及其制备方法,通过使透明导电胶与OLED发光器件中的第一电极层直接接触,一方面,由于透明导电胶与第一电极层的并联电阻小于第一电极层的电阻,因此,可在第一电极层较薄的情况下,避免因第一电极层的电阻过大,导致显示画面的刷新速率减慢、以及第一电极层的IR drop过大的问题,提高用户体验;另一方面,由于本申请的透明导电胶用于粘接阵列基板与封装盖板时,原本就应该与第一电极层直接接触,因此,无需像现有技术一样利用激光打孔的方式或跨接工艺使透明导电胶与第一电极层电连接,从而避免因激光打孔工艺或跨接工艺难度过大导致的顶发光型OLED显示面板良率下降的问题;另一方面,本发明实施例无需在顶发光型OLED面板中增加额外的结构,使其与第一电极层电连接,因此,相对于相关技术来说,可简化制备顶发光型OLED显示面板的工艺步骤,还可避免用于连接阴极与辅助电极的ITO断裂,影响显示效果。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1为相关技术提供的一种顶发光型OLED显示面板的结构示意图;

[0020] 图2为本发明实施例提供的一种顶发光型OLED显示面板的结构示意图一;

[0021] 图3为本发明实施例提供的一种顶发光型OLED显示面板的结构示意图二;

[0022] 图4为本发明实施例提供的一种形成透明导电胶的方法示意图一;

[0023] 图5为本发明实施例提供的一种形成透明导电胶的方法示意图二。

[0024] 附图标记:

[0025] 1-阴极;2-辅助电极;3-隔垫物;4-ITO;10-阵列基板;11-薄膜晶体管;111-栅极;112-栅绝缘层;113-有源层;114-源极;115-漏极;12-OLED发光器件;121-第二电极层;122-发光功能层;123-第一电极层;20-封装盖板;21-隔垫物;22-导电层;23-黑矩阵;24-彩色滤光层;30-透明导电胶。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0027] 相关技术中,如图1所示,顶发光型OLED显示面板包括阵列基板和封装盖板,阵列基板包括OLED发光器件,OLED发光器件包括阴极1;阵列基板与封装盖板之间设置有隔垫物3和辅助电极2,辅助电极2通过锡氧化铟(Indium Tin Oxide,简称ITO)与阴极电连接。

[0028] 然而,发明人发现,该方式不但增加了制备顶发光型OLED显示面板的工艺步骤,而且,ITO的硬度比较大,在实际应用中存在断裂的风险。

[0029] 基于此,本发明实施例提供一种顶发光型OLED显示面板,如图2所示,包括阵列基板10和封装盖板20,阵列基板10包括OLED发光器件12,OLED发光器件12包括发光功能层122、以及设置于发光功能层122靠近封装盖板20一侧的第一电极层123,还包括填充于阵列基板10与封装盖板20之间、用于粘接阵列基板10与封装盖板20的透明导电胶30;其中,透明导电胶30与第一电极层123直接接触。

[0030] 本领域的技术人员应该知道,阵列基板10与封装盖板20可利用具有粘附性的透明填充胶进行对盒,本发明实施例的透明导电胶30不但可以使阵列基板10与封装盖板20对盒,还具有一定导电性。

[0031] 在此基础上,阵列基板10还包括衬底,以及设置在衬底上的薄膜晶体管11,薄膜晶体管11包括栅极111、栅绝缘层112、有源层113、源极114、以及漏极115;OLED发光器件12还包括设置于发光功能层122远离第一电极层123一侧的第二电极层121,所述第二电极层121由多个块状电极构成,且每个块状电极均和与其对应的薄膜晶体管11的漏极115电连接。其中,第一电极层123可以是OLED发光器件12的阴极,第二电极层121是OLED发光器件12的阳极。

[0032] 所述顶发光型OLED显示面板还可以包括彩色滤光层、以及黑矩阵,如图3所示,彩色滤光层24和黑矩阵23设置于封装盖板20上。

[0033] 需要说明的是,第一,不对透明导电胶30的材料进行限定,只要其具有一定光透过率、具有粘附性、且具有导电性即可。

[0034] 示例的,透明导电胶30包括树脂、以及掺杂在树脂中的导电粒子构成,为了使透明导电胶30各个位置的导电性能相同,导电粒子在树脂中均匀掺杂。其中,导电粒子可以是石墨烯、碳纳米管、足球烯、金属纳米颗粒、以及金属纳米线中的至少一种。

[0035] 透明导电胶30还可以是具有粘附性的导电聚合物,例如透明导电胶30可以是聚噻吩,在聚合之前,噻吩单体具有一定的流动性,将噻吩单体溶液涂覆在封装盖板20上,之后,对噻吩单体进行紫外光辐照及热处理,促使噻吩单体之间发生聚合反应生成聚噻吩固体,

然后将阵列基板10与封装盖板20贴附在一起,聚噻吩固体冷却固化后完成阵列基板10与封装盖板20的对盒。

[0036] 当然,为了使第一电极层123与透明导电胶30的并联电阻尽可能小,在不改变透明导电胶30的形状及尺寸的情况下,选取电阻率较小的材料作为透明导电胶30的材料。

[0037] 第二,不对第一电极层123的材料进行限定,第一电极层123的材料可以是银(Ag)、Al、钙(Ca)、铟(In)、锂(Li)、镁(Mg)等金属;第一电极层123的材料也可以是ITO、氧化铟锌(Indium Zinc Oxide,简称IZO)等透明导电材料。

[0038] 本发明实施例提供一种顶发光型OLED显示面板,通过使透明导电胶30与OLED发光器件12中的第一电极层123直接接触,一方面,由于透明导电胶30与第一电极层123的并联电阻小于第一电极层123的电阻,因此,可在第一电极层123较薄的情况下,避免因第一电极层123的电阻过大,导致显示画面的刷新速率减慢、以及第一电极层123的IR drop过大的问题,提高用户体验;另一方面,由于本申请的透明导电胶30用于粘接阵列基板10与封装盖板20时,原本就应该与第一电极层123直接接触,因此,无需像现有技术一样利用激光打孔的方式或跨接工艺使透明导电胶30与第一电极层123电连接,从而避免因激光打孔工艺或跨接工艺难度过大导致的顶发光型OLED显示面板良率下降的问题;另一方面,本发明实施例无需在顶发光型OLED面板中增加额外的结构,使其与第一电极层123电连接,因此,相对于相关技术来说,可简化制备顶发光型OLED显示面板的工艺步骤,还可避免用于连接阴极1与辅助电极2的ITO4断裂,影响显示效果。

[0039] 优选的,如图3所示,封装盖板20包括多个子像素区域、以及位于相邻子像素区域之间的非子像素区域,封装盖板20的非子像素区域设置有隔垫物21和导电层22;其中,导电层22与透明导电胶30直接接触。

[0040] 需要说明的是,第一,如图3所示,封装盖板20还包括黑矩阵23和彩色绿光层24,在顶发射型OLED显示面板的显示区域中,黑矩阵23所在的区域为封装盖板20的非子像素区域,除非子像素区域以外的区域为子像素区域。

[0041] 第二,隔垫物21与导电层22在黑矩阵23上的投影可以相同,也可以不相同,只要隔垫物21与导电层22在黑矩阵23上的投影都位于黑矩阵23所在范围内、且导电层22与透明导电胶30直接接触即可。

[0042] 第三,导电层22可以设置于隔垫物21靠近阵列基板10一侧;或者,导电层22也可以设置于隔垫物21远离阵列基板10一侧。

[0043] 其中,当导电层22设置于隔垫物21远离阵列基板10一侧时,隔垫物21并未完全覆盖导电层22,以使得导电层22与透明导电胶30直接接触。

[0044] 第四,不对导电层22的形状进行限定,导电层22可以由多个块状的导电块构成,也可以由多个导电条构成。

[0045] 第五,不对导电层22的材料进行限定,导电层22的材料可以是IZO、ITO等透明导电材料,也可以是金属。

[0046] 由于导电层22设置于封装盖板20的非子像素区域,因此,即使导电层22的材料是金属,也不会影响顶发光型OLED显示面板的正常显示。

[0047] 此处,由于金属的韧性大于透明导电材料的韧性,且金属的电阻率通常小于透明导电材料的电阻率,因此,优选导电层22的材料为金属。

[0048] 本发明实施例中,通过在封装盖板20的非子像素区域设置导电层22,并使得导电层22与透明导电胶30直接接触,这样一来,相对于第一电极层123与透明导电胶30的并联电阻,第一电极层123、透明导电胶30、以及导电层22的并联电阻可进一步减小,从而进一步减小第一电极层123的IR drop,提高显示画面的刷新速率,以提高用户的体验。

[0049] 本发明实施例提供一种顶发光型OLED显示面板的制备方法,如图1所示,所述顶发光型OLED显示面板包括发光功能层122、以及设置于发光功能层122靠近封装盖板20一侧的第一电极层123,所述制备方法包括:在阵列基板10与封装盖板20之间填充透明导电胶30,透明导电胶30用于粘结阵列基板10与封装盖板20;其中,透明导电胶30与第一电极层123直接接触。

[0050] 需要说明的是,第一,不对透明导电胶30的材料进行限定,只要其具有一定光透过率、具有粘附性、且具有导电性即可。

[0051] 示例的,透明导电胶30包括树脂、以及掺杂在树脂中的导电粒子构成,为了使透明导电胶30各个位置的导电性能相同,导电粒子在树脂中均匀掺杂。其中,导电粒子可以是石墨烯、碳纳米管、足球烯、金属纳米颗粒、以及金属纳米线中的至少一种。

[0052] 透明导电胶30还可以是具有粘附性的导电聚合物,例如透明导电胶30可以是聚噻吩,在聚合之前,噻吩单体具有一定的流动性,将噻吩单体溶液涂覆在封装盖板20上,之后,对噻吩单体进行紫外光辐照及热处理,促使噻吩单体之间发生聚合反应生成聚噻吩固体,然后将阵列基板10与封装盖板20贴附在一起,聚噻吩固体冷却固化后完成阵列基板10与封装盖板20的对盒。

[0053] 当然,为了使第一电极层123与透明导电胶30的并联电阻尽可能小,在不改变透明导电胶30的形状及尺寸的情况下,选取电阻率较小的材料作为透明导电胶30的材料。

[0054] 第二,不对第一电极层123的材料进行限定,第一电极层123的材料可以是银(Ag)、Al、钙(Ca)、铟(In)、锂(Li)、镁(Mg)等金属;第一电极层123的材料也可以是ITO、氧化铟锌(Indium Zinc Oxide,简称IZO)等透明导电材料。

[0055] 第三,在制备顶发光型OLED显示面板时,如图4所示,透明导电胶30可以形成于阵列基板10上;如图5所示,透明导电胶30也可以形成于封装盖板20上。

[0056] 考虑到阵列基板上设有发光功能层122,发光功能层122易受高温等外界环境影响,影响其发光特性,因此,优选透明导电胶30形成于封装盖板20上。

[0057] 本发明实施例提供一种顶发光型OLED显示面板的制备方法,通过使透明导电胶30与OLED发光器件12中的第一电极层123直接接触,一方面,由于透明导电胶30与第一电极层123的并联电阻小于第一电极层123的电阻,因此,可在第一电极层123较薄的情况下,避免因第一电极层123的电阻过大,导致显示画面的刷新速率减慢、以及第一电极层123的IR drop过大的问题,提高用户体验;另一方面,由于本申请的透明导电胶30用于粘接阵列基板10与封装盖板20时,原本就应该与第一电极层123直接接触,因此,无需像现有技术一样利用激光打孔的方式或跨接工艺使透明导电胶30与第一电极层123电连接,从而避免因激光打孔工艺或跨接工艺难度过大导致的顶发光型OLED显示面板良率下降的问题;另一方面,本发明实施例无需在顶发光型OLED面板中增加额外的结构,使其与第一电极层123电连接,因此,相对于相关技术来说,可简化制备顶发光型OLED显示面板的工艺步骤,还可避免用于连接阴极1与辅助电极2的ITO4断裂,影响显示效果。

[0058] 可选的,如图3所示,封装盖板20包括多个子像素区域、以及位于相邻子像素区域之间的非子像素区域,所述方法还包括:在封装盖板20的非子像素区域形成隔垫物21和导电层22;其中,导电层22与透明导电胶30直接接触。

[0059] 需要说明的是,第一,如图3所示,封装盖板20还包括黑矩阵23和彩色滤光层24,在顶发射型OLED显示面板的显示区域中,黑矩阵23所在的区域为封装盖板20的非子像素区域,除非子像素区域以外的区域为子像素区域。

[0060] 第二,隔垫物21与导电层22在黑矩阵23上的投影可以相同,也可以不相同,只要隔垫物21与导电层22在黑矩阵23上的投影都位于黑矩阵23所在范围内、且导电层22与透明导电胶30直接接触即可。

[0061] 第三,在封装盖板20的非子像素区域形成隔垫物21和导电层22,包括:在封装盖板20的非子像素区域依次形成隔垫物21和导电层22;或者,在封装盖板20的非子像素区域依次形成导电层22和隔垫物21。此处,隔垫物21和导电层22均形成于封装盖板20靠近阵列基板10一侧。

[0062] 其中,当在封装盖板20的非子像素区域依次形成导电层22和隔垫物21时,隔垫物21并未完全覆盖导电层22,以使得导电层22与透明导电胶30直接接触。

[0063] 第四,不对导电层22的形状进行限定,导电层22可以由多个块状的导电块构成,也可以由多个导电条构成。

[0064] 第五,不对导电层22的材料进行限定,导电层22的材料可以是IZO、ITO等透明导电材料,也可以是金属。

[0065] 由于导电层22设置于封装盖板20的非子像素区域,因此,即使导电层22的材料是金属,也不会影响顶发光型OLED显示面板的正常显示。

[0066] 此处,由于金属的韧性大于透明导电材料的韧性,且金属的电阻率通常小于透明导电材料的电阻率,因此,优选导电层22的材料为金属。

[0067] 本发明实施例中,通过在封装盖板20的非子像素区域设置导电层22,并使得导电层22与透明导电胶30直接接触,这样一来,相对于第一电极层123与透明导电胶30的并联电阻,第一电极层123、透明导电胶30、以及导电层22的并联电阻可进一步减小,从而进一步减小第一电极层123的IR drop,提高显示画面的刷新速率,以提高用户的体验。

[0068] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

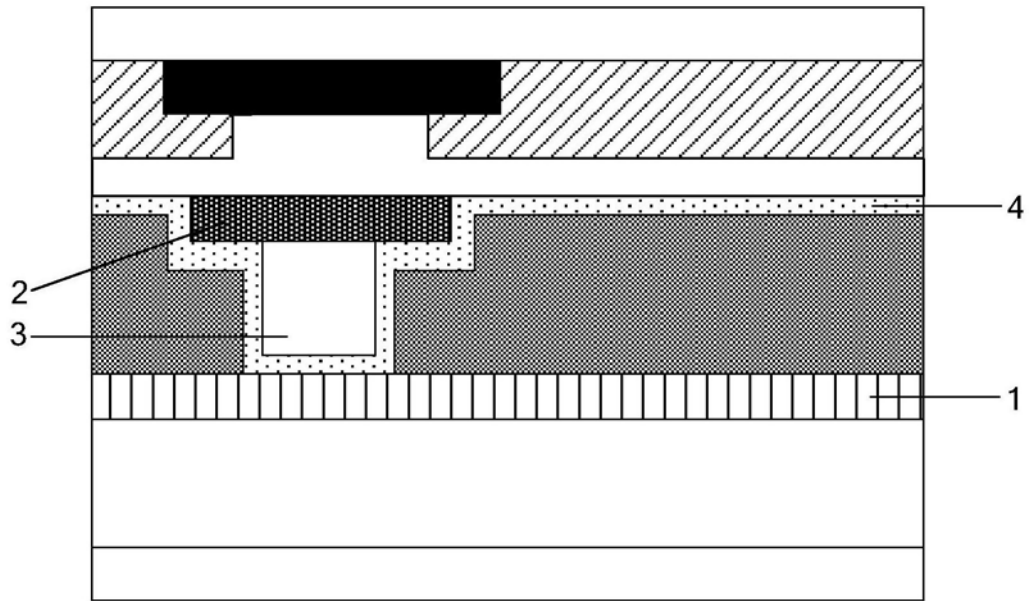


图1

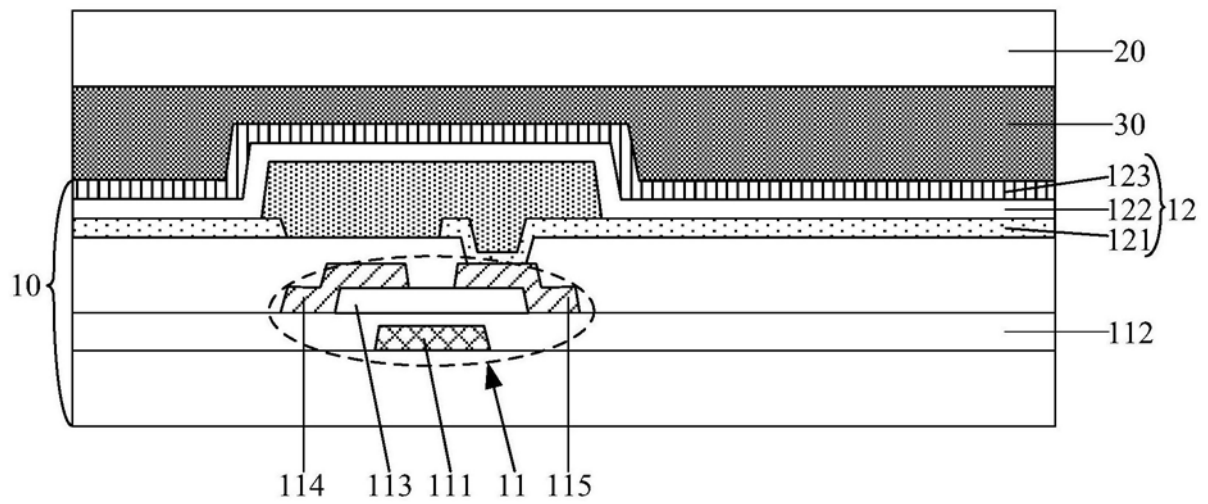


图2

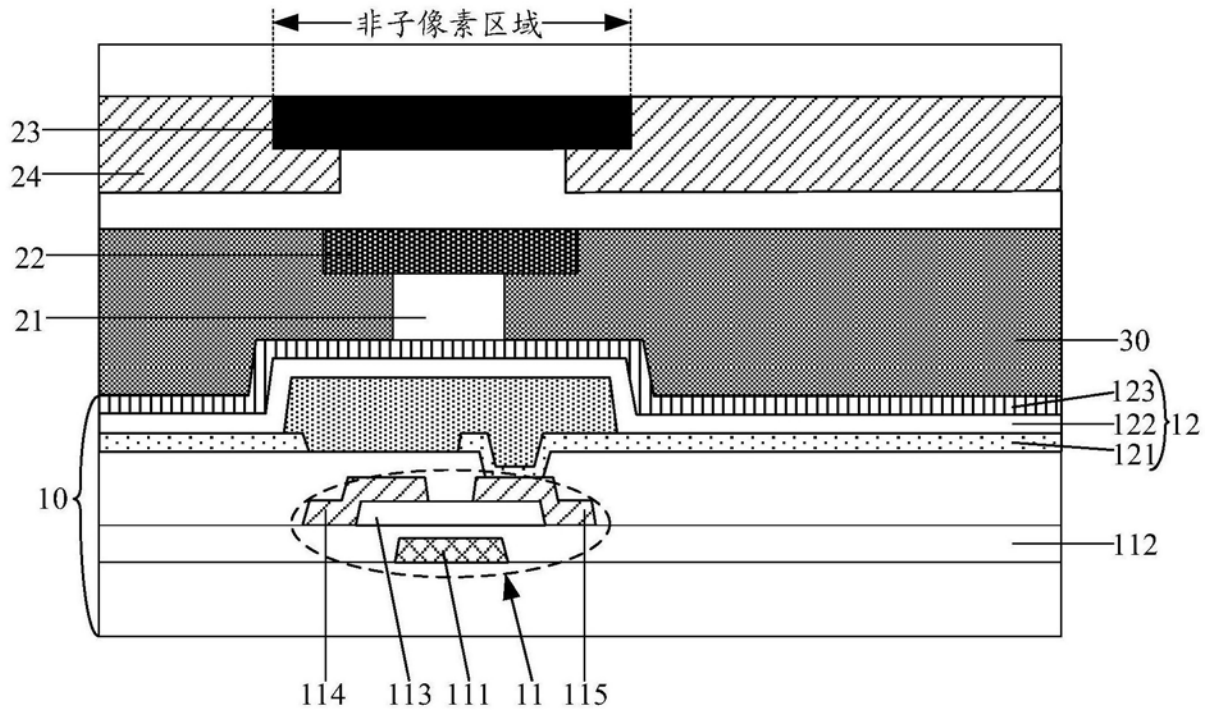


图3

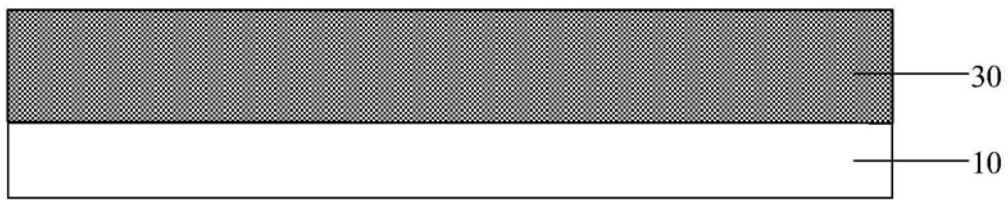


图4



图5

专利名称(译)	一种顶发光型OLED显示面板及其制备方法		
公开(公告)号	CN109065753A	公开(公告)日	2018-12-21
申请号	CN201810873612.X	申请日	2018-08-02
[标]申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司		
[标]发明人	谢蒂旒 李伟		
发明人	谢蒂旒 李伟		
IPC分类号	H01L51/52 H01L27/32		
CPC分类号	H01L27/3244 H01L51/5246 H01L2227/323 H01L27/3246 H01L27/3279 H01L51/5228 H01L51/5234 H01L51/5253 H01L2251/5315 H01L51/5012 H01L2251/5369		
代理人(译)	申健		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明实施例提供一种顶发光型OLED显示面板及其制备方法，涉及显示技术领域，可在不影响顶发光型OLED显示面板的良率的情况下，提高顶发光型OLED显示面板的显示效果。一种顶发光型OLED显示面板，包括阵列基板和封装盖板，所述阵列基板包括OLED发光器件，所述OLED发光器件包括发光功能层、以及设置于所述发光功能层靠近所述封装盖板一侧的第一电极层，还包括填充于所述阵列基板与所述封装盖板之间、用于粘接所述阵列基板与所述封装盖板的透明导电胶；其中，所述透明导电胶与所述第一电极层直接接触。

